









	<p><b>SI4628DY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4628DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 38A 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4628DY-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19163 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4628DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 38A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19163 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 7.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3450pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

SI4628DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4628DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4628DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4628DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI462DP</b> VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p><b>SI4629-A10-AM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL RADIO SGL CHIP 48QFN</p>	 <p><b>SI4626DY-T1-E3</b> VISHAY SI4626DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4629-A10-AMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC DGTL RADIO SGL CHIP 48QFN</p>
 <p><b>SI4628DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 38A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4626ADY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4626ADY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4626ADY-T1-E3</b> VISHAY SI4626ADY-T1-E3 VISHAY</p>

### SI4628DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI4628DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI4628DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4628DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4628DY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4628DY-T1-GE3
SI4628DY-T1-GE3 Electronic	SI4628DY-T1-GE3-Komponenten	SI4628DY-T1-GE3-Verteiler	SI4628DY-T1-GE3-Bild	SI4628DY-T1-GE3-Teil
SI4628DY-T1-GE3 Preis	SI4628DY-T1-GE3 Hersteller	SI4628DY-T1-GE3 Bild	SI4628DY-T1-GE3 Aktie	SI4628DY-T1-GE3 Inventar
SI4628DY-T1-GE3 Neu	SI4628DY-T1-GE3 Original	SI4628DY-T1-GE3 garantiert	SI4628DY-T1-GE3 RFQ	SI4628DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited